

2SD219, 2SD220, 2SD221

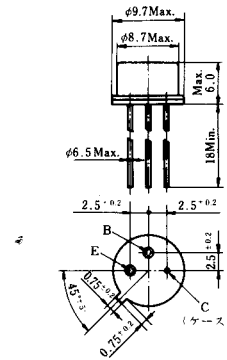
■シリコンNPN両面拡散形トランジスタ

- 一般用
- 通信産業用
- 指定通信工業用

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SD219	2SD220	2SD221
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	40V	80V	110V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	30V	50V	80V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-6V		
コレクタ電流	I _C	1A		
ベース電流	I _B	0.5A		
許容コレクタ損失	P _C	0.5W		
接合部温度	T _j	150°C		
保存温度	T _{stg}	-65~+150°C		

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC(TO-5), EIAJ(TC-5, TB-5B)



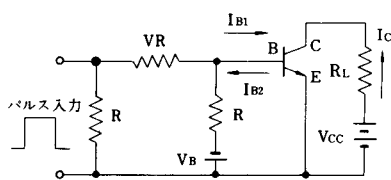
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SD219	2SD220	2SD221
最大コレクタしゃ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = 20V	1μA		
最大エミッタしゃ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = 5V	5μA		
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CEO}	I _C = 5mA	30V	50V	80V
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} = 4V I _C = 0.2A	40Min. 80Typ.		
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 0.5A I _B = 0.05A	0.5V Max. 0.3V Typ.		
しゃ断周波数	f _{αb}	V _{CB} = 5V I _E = -0.1A	8MHz Typ. 4MHz min.		

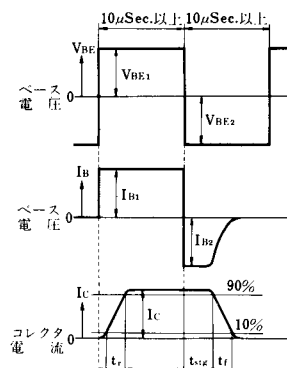
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _r (μSec.)	t _{stg} (μSec.)	t _f (μSec.)
10	20	0.5	100	-50	0.3	2.4	2.6

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

